

## 2SD889

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

低周波増幅用

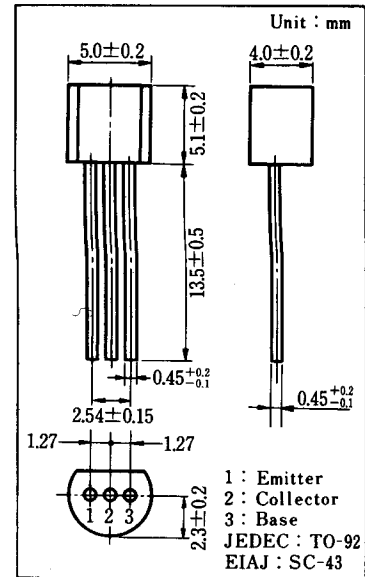
2SB774 とコンプリメンタリ

## ■ 特長

- エミッタ・ベース電圧  $V_{EBO}$  が高い。
- エミッタ・ベース間の保護用ダイオード、抵抗が省略できる。

■ 絶対最大定格 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	30	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	25	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	15	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	200	mA
コレクタ電流	$I_C$	100	mA
コレクタ損失	$P_C$	400	mW
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 ( $T_a=25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0$			1	$\mu\text{A}$
	$I_{CEO}$	$V_{CE}=20\text{ V}, I_B=0$			100	
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	$I_C=10\ \mu\text{A}, I_E=0$	30			V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C=2\text{ mA}, I_B=0$	25			V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	$I_E=10\ \mu\text{A}, I_C=0$	15			V
直流電流増幅率	$h_{FE1}^*$	$V_{CE}=10\text{ V}, I_C=2\text{ mA}$	120		650	
	$h_{FE2}$	$V_{CE}=2\text{ V}, I_C=100\text{ mA}$	90			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{ mA}, I_B=10\text{ mA}$			0.5	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=-2\text{ mA}, f=200\text{ MHz}$		150		MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10\text{ V}, I_E=0, f=1\text{ MHz}$		3		pF

\*  $h_{FE1}$  ランク分類

ランク	P	Q	R	S	T
$h_{FE1}$	120~200	160~260	210~340	290~460	400~650